



## 「パワーデバイスの特性を左右する点欠陥・拡張欠陥」

◇ 日時: 2025 年 3 月 11 日(火) 13:00~17:45

◇ 場所: 京都テルサ 東館 3 階 大会議室

<https://www.kyoto-terrsa.or.jp/>

電力変換を担うパワーデバイスの高性能化に向けて、半導体内部の結晶欠陥の理解は重要である。多くの場合、結晶欠陥はデバイス特性の悪化や信頼性低下を引き起こすが、欠陥物性、導入起源などを深く理解することで、逆に欠陥を利用し、材料物性の制御、ひいては性能向上につなげることも可能である。本研究会では、パワーデバイスに現在使用されている、あるいは今後実用化が期待される各種材料の欠陥に関する専門家にご講演頂き、材料横断的に議論することで理解を深める。

.....プログラム.....

13:00~13:05 開会挨拶

13:05~13:55 シリコン中の微量炭素不純物のパワーデバイスへの影響とその定量法の標準化  
田島 道夫 (宇宙科学研究所)

13:55~14:45 炭化ケイ素中の拡張欠陥の全体像に関して  
大谷 昇 (関西学院大学)

14:45~15:35 窒化ガリウム中の点欠陥と深い準位の評価  
堀田 昌宏 (名古屋大学)

15:35~16:00 休 憩

16:00~16:50  $\beta$  型酸化ガリウム中の転位の観察  
姚永昭 (三重大学)

16:50~17:40 ダイヤモンド中の欠陥とデバイス特性の関係に関して  
鹿田 真一 (関西学院大学)

17:40~17:45 閉会挨拶

.....

■参加受付: WEB 参加受付システム ([ここをクリック](#)\*) から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。なお、当日の資料は PDF 版となります。

\*本案内が印刷物の場合、<https://annex.jsap.or.jp/adps/pdf/kenkyuukai29.pdf> よりアクセスして下さい。

■参加費: (消費税込)

先進パワー半導体分科会会員\* 4,000 円、分科会学生会員 無料、一般 6,000 円、一般学生 1,000 円

\*先進パワー半導体分科会賛助会員所属の方は先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■現地開催におけるご協力のご願い: 発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。会場でのマスクの着用は任意とします。

問合せ先:

金子 光顕 (京都大学)

e-mail: kaneko@semicon.kuee.kyoto-u.ac.jp

中川 聡子 (グローバルウェーハズ・ジャパン)

e-mail: Satoko\_Nakagawa@sas-globalwafers.co.jp

徳田 規夫 (金沢大学)

e-mail: tokuda@ec.t.kanazawa-u.ac.jp

白石 陽子 (応用物理学会事務局)

e-mail: shiraishi@jsap.or.jp